



www.jdsemi.cn

深圳市晶导电子有限公司
ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

CMN65F
POWER MOSFET

650V N-Channel VDMOS

使用及贮存时需防静电

符合RoHS等环保指令要求

1. 主要用途

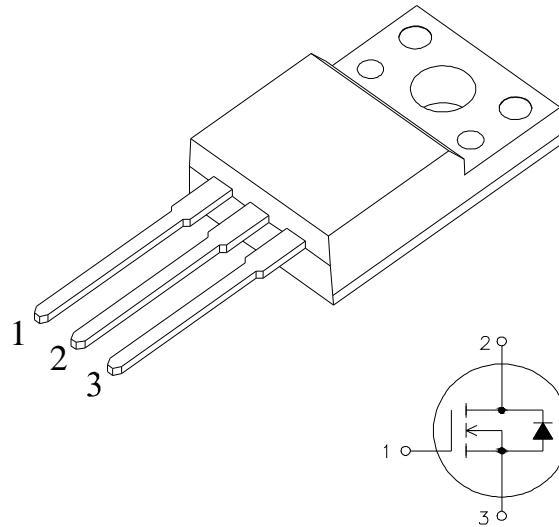
主要用于充电器、LED驱动、电源适配器
等各类功率开关电路

2. 主要特点

- | 开关速度快
- | 通态电阻小，输入电容小

3. 封装外形

TO-220FH



4. 电特性

4.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25$

参数名称	符号	额定值	单位
漏极-源极电压	V_{DSS}	650	V
连续漏极电流	I_D	7	A
漏极脉冲电流	I_{DM}	28	A
栅源电压	V_{GS}	± 30	V
单脉冲雪崩能量	E_{AS}	350	mJ
热阻(结到壳)	R_{JC}	3.28	/W
耗散功率($T_a=25$)	P_{tot}	38	W
结温	T_j	150	
贮存温度	T_{stg}	-55 ~ 150	

4.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650			V
通态电阻	$R_{DS(on)}^*$	$V_{GS}=10V, I_D=3.5A$		1.1	1.4	
阈值电压	$V_{GS(TH)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$	2		4	V
漏源漏电流	$I_{DS(on)}$	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V$			25	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V$			± 100	nA
源漏二极管正向压降	V_{SD}^*	$I_S=7A, V_{GS}=0V$			1.5	V
关断延迟时间	$t_{d(off)}$	$V_{DD}=300V, I_D=7.0A$ $R_G=4.7, V_{GS}=10V$		26		ns
输入电容	C_{iss}	$V_{GS}=0V, V_{DS}=25V$ $f=1.0MHz$		1380		pF

* 脉冲测试 : $t_p = 300\mu s, 2\%$
 * $L=10mH, I_D=7A, T_j=25$

地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园3号厂房 电话：0755-29799516 传真：0755-29799515

4 特性曲线

图 1 安全工作区 (直流)

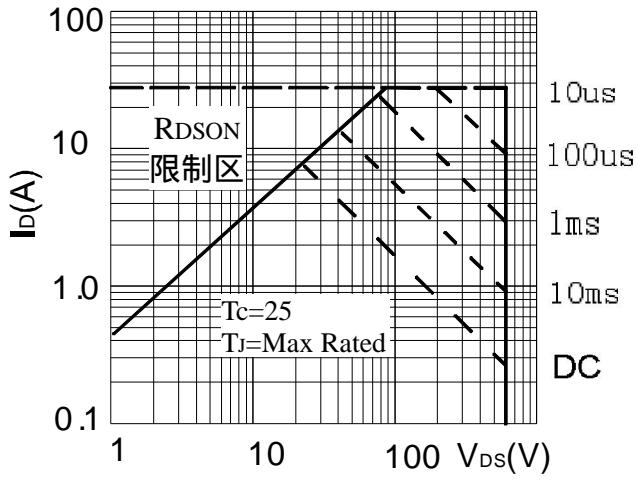


图 2 Ptot-T关系曲线

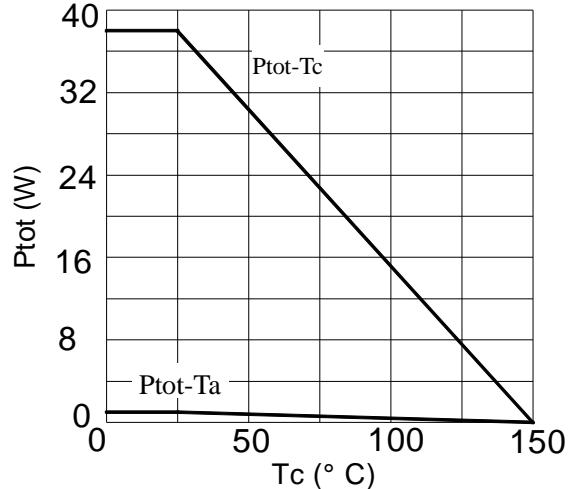


图 3 传输特性曲线

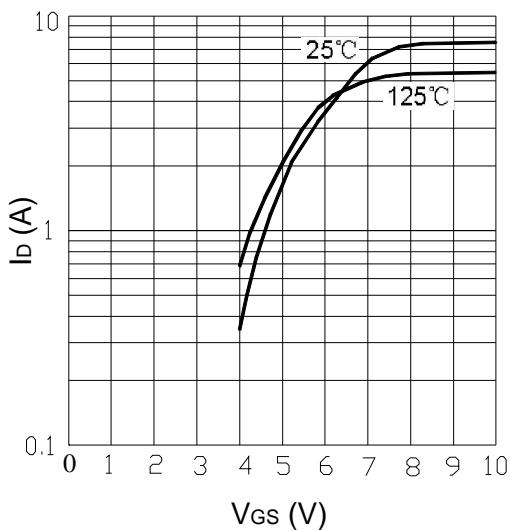


图 5 击穿电压 温度关系曲线

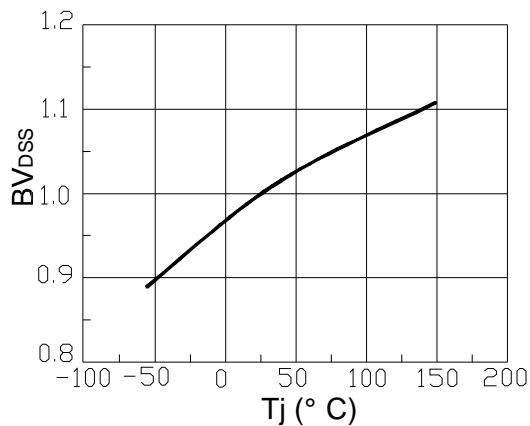


图 4 通态电阻-温度关系曲线

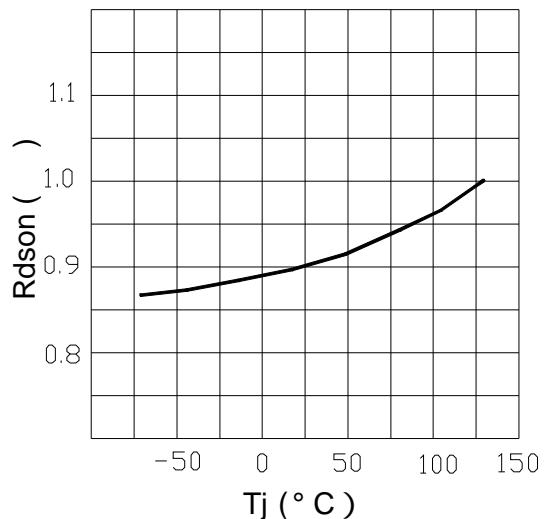
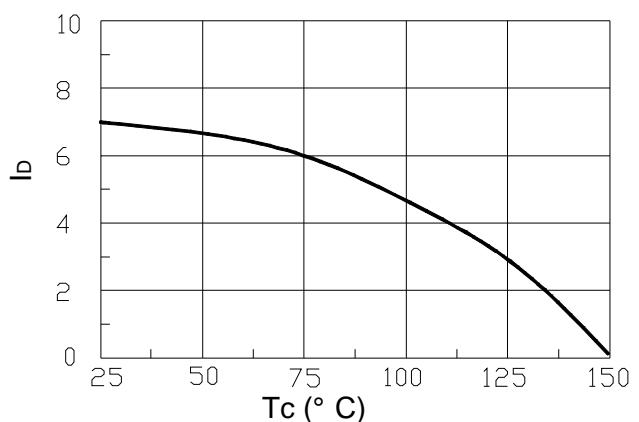


图 6 漏极电流 温度关系曲线



6. 产品外形尺寸图 (单位 : mm)

TO-220FH

